

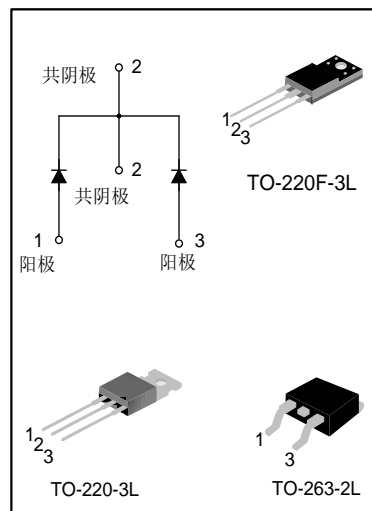
30A、200V肖特基整流管

描述

SR30200T/F/S 是采用硅外延工艺制作而成的肖特基整流二极管，广泛应用于开关电源、保护电路等各类电子线路中。

特点

- ◆ 高电流冲击能力
- ◆ 低功耗高效率
- ◆ 正向压降低



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装
SR30200T	TO-220-3L	SR30200T	无铅	料管
SR30200F	TO-220F-3L	SR30200F	无卤	料管
SR30200S	TO-263-2L	SR30200S	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	额定值	单位
最大反向峰值电压	V_{RRM}	200	V
正向平均整流电流	I_{FAV}	15X2	A
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	180	A
工作结温范围	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
芯片存储温度范围	T_{STG}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

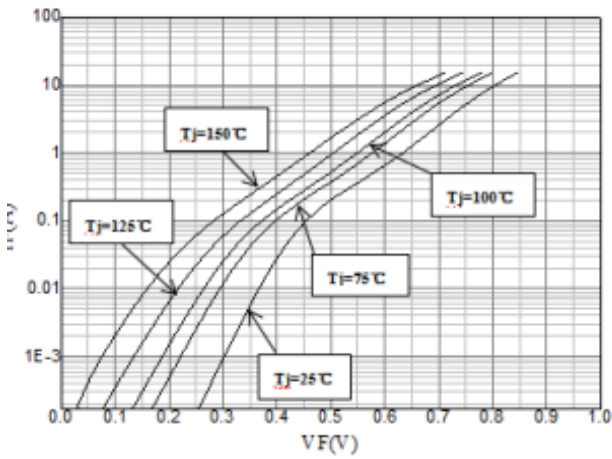
参数名称	符号	额定值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta jc}$	2.0	$^{\circ}\text{C/W}$

电参数规格

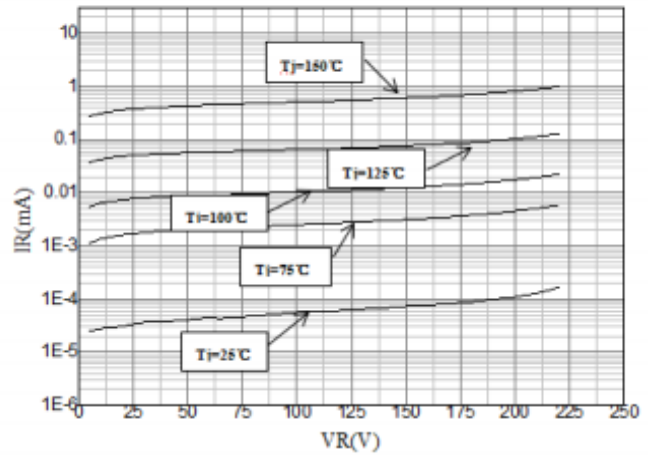
参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=30A, T_C=25^\circ C$	--	0.94	V
		$I_F=30A, T_C=125^\circ C$	--	0.82	V
反向漏电流	I_R	$V_R=200V, T_C=25^\circ C$	--	5	μA
		$V_R=200V, T_C=125^\circ C$	--	5	mA

典型特性曲线

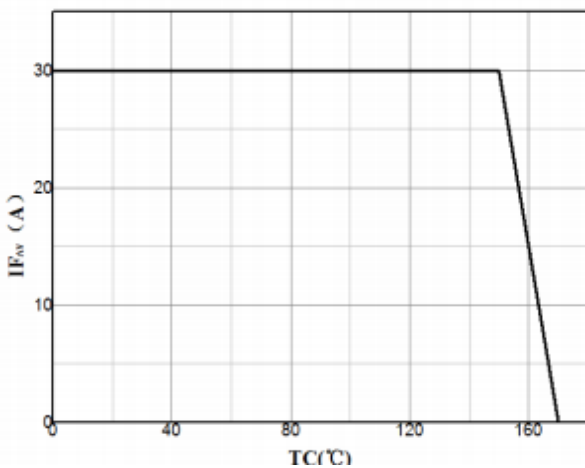
I_F vs V_F



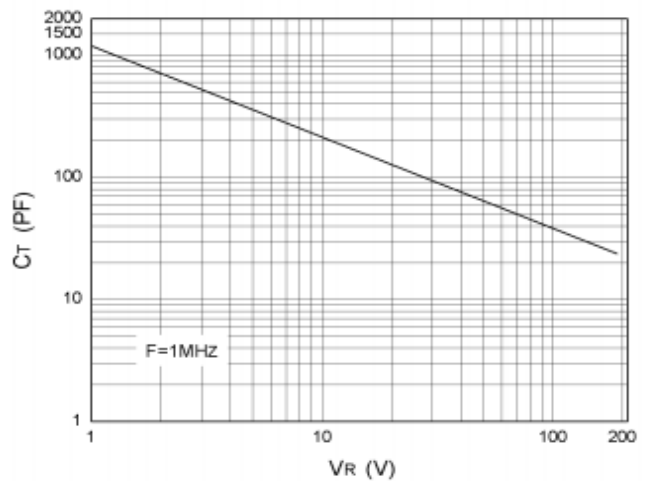
I_R vs V_R



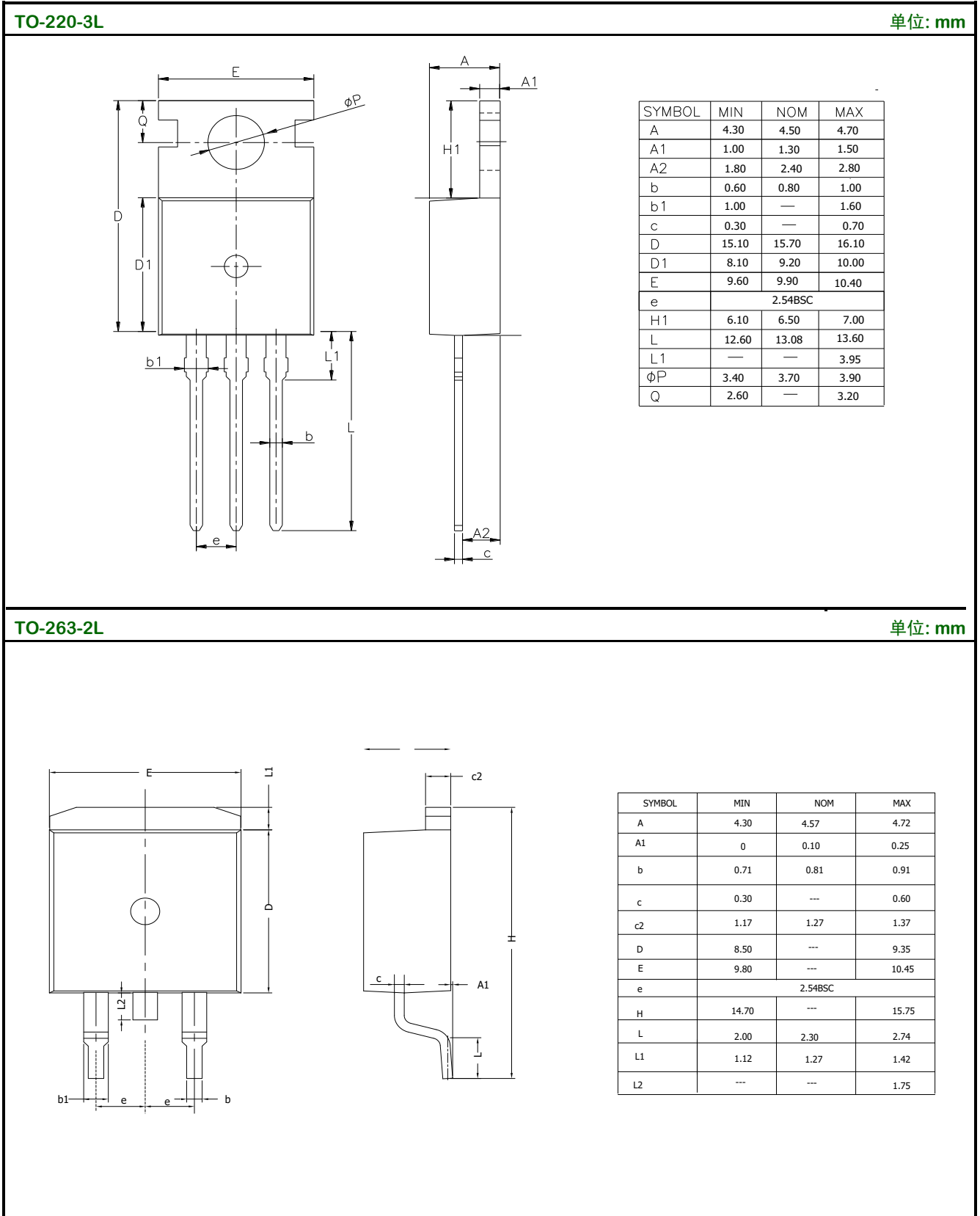
$I_{F(AV)}$ vs T_C



C_T vs V_R



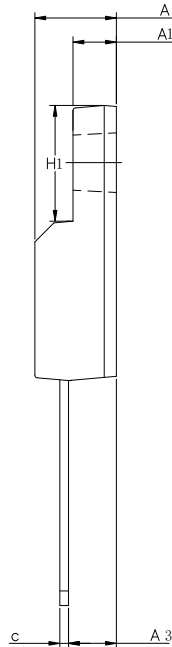
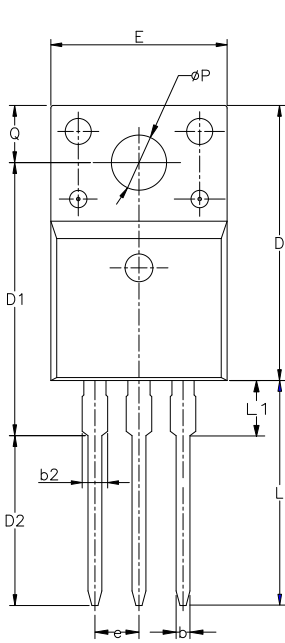
封装外形图



封装外形图 (续)

TO-220F-3L

单位: mm



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

产品名称： SR30200T/F/S

文档类型：说明书

版 权：意盛微（上海）电子有限公司

公司主页：WWW.SXCAI.COM

版 本： 1.0

修改记录：

1. 原本
